#### **NOVEL PHOTOSTRUCTURABLE ORGANIC SEMICONDUCTOR MATERIALS**

Publication number: WO0221611

Publication date:

2002-03-14

Inventor:

KANITZ ANDREAS (DE); ROGLER WOLFGANG (DE)

Applicant:

SIEMENS AG (DE); KANITZ ANDREAS (DE); ROGLER

WOLFGANG (DE)

Classification:

- international:

C07D305/06; C07D409/12; C07D409/14; H01L51/30; H01L51/40; C07D305/00; C07D409/00; H01L51/05; (IPC1-7): H01L51/20; C07D305/06; C07D409/12;

C07D409/14; H01L51/30

- european:

H01L51/00A2B; C07D305/06; C07D409/12;

C07D409/14; H01L51/00A4B; H01L51/00M2B2;

H01L51/00M6F

Application number: WO2001DE03346 20010830 Priority number(s): DE20001044840 20000911

Also published as:

EP1410448 (A1) EP1410448 (A0) DE10044840 (A1)

Cited documents:

DE3827221 EP0848294

EP0728790 FR1501297

more >>

DE19913543

Report a data error here

#### Abstract of WO0221611

The invention relates to novel photostructurable organic semiconductor materials with improved processability, especially with regard to producing organic light-emitting diodes (OLEDs). The inventive semiconductors are produced by cross-linking oxetane-functionalized compounds on the substrate.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 14. März 2002 (14.03.2002)

PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/21611 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: 51/30, C07D 305/06, 409/14, 409/12

H01L 51/20,

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/03346

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. August 2001 (30.08.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 100 44 840.2 11. September 2000 (11.09.2000)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KANITZ, Andreas [DE/DE]; Nackendorf 27, 91315 Höchstadt (DE).
  ROGLER, Wolfgang [DE/DE]; Frankenstrasse 44, 91096 Möhrendorf (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

#### Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten JP, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: NOVEL PHOTOSTRUCTURABLE ORGANIC SEMICONDUCTOR MATERIALS

(54) Bezeichnung: PHOTOSTRUKTURIERBARE NEUE ORGANISCHE HALBLEITERMATERIALIEN

(57) Abstract: The invention relates to novel photostructurable organic semiconductor materials with improved processability, especially with regard to producing organic light-emitting diodes (OLEDs). The inventive semiconductors are produced by cross-linking oxetane-functionalized compounds on the substrate.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft neue organische Halbleitermaterialien mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften speziell im Hinblick auf die Herstellung von organischen Licht emittierenden Leuchtdioden (OLEDs). Die Halbleiter werden durch Vernetzung von oxetan-funktionalisierten Verbindungen auf dem Substrat erzeugt.



PCT/DE01/03346 WO 02/21611

Beschreibung

Photostrukturierbare neue organische Halbleitermaterialien

Die Erfindung betrifft neue organische Halbleitermaterialien mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften speziell im Hinblick auf die Herstellung von organischen Licht emittierenden Leuchtdioden (OLEDs).

OLEDs haben einen Schichtaufbau, der aus einem transparenten Träger (Glas, Kunststoff), einer darauf befindlichen Anode 10 (z.B. aus ITO (Indium-Tin-Oxid)) zumindest einer organischen halbleitenden Schicht und schließlich aus einer Kathode besteht.

15

Die Effektivität des OLED hängt erheblich davon ab, ob die halbleitende Schicht aus einer (Einschichtsystem) oder mehreren Schichten (Mehrschichtsystem) aufgebaut ist. Die Mehrschichtsysteme sind effektiver und emittieren stärker. Zur Bildung der bevorzugten Mehrschichtsysteme eignen sich niedermolekulare Substanzen besser als polymere, weil bestehende 20 polymere Schichten durch Aufbringung von angrenzenden polymeren Schichten mittels Spin-coating, Gießen oder Rakeln verändert und beschädigt werden. Selbst beim Einsatz sogenannter orthogonaler Lösungsmittel, in denen die bereits hergestellten Schichten unlöslich sind, wird normalerweise die Oberflä-25 che angelöst und/oder angequollen. Dadurch werden die Moleküle der verschiedenen halbleitenden Schichten, also die Lochtransport- und/oder Elektronentransportmoleküle unter Umständen vermischt und/oder an der Grenzschicht ausgedünnt, was je nach Anwendung ein Nachteil (Reduktion der Lebensdauer und 30 Effizienz) sein kann. Diese Problematik wird in der Literatur beschrieben, wie beispielsweise in der US-Patentschrift 4539507.

35

Andererseits sind die polymeren halbleitenden Materialien gegenüber den niedermolekularen halbleitenden Materialien beWO 02/21611 PCT/DE01/03346

vorzugt, weil sie die höhere Glasübergangstemperatur und damit die geringere Kristallisationstendenz haben.

2

Zwar ist die Vernetzung und die Erhöhung der Glasübergangstemperatur des organischen Halbleiters auf dem Substrat beispielsweise aus der DE 4325885 Al bekannt, jedoch birgt die Vernetzung einer Schicht in, auf einem elektronischen und/oder optischen Prozess basierenden, Anordnungen auch Probleme in sich: Rissbildungen in den Filmen während der Vernetzung und/oder einzelne, bei der Vernetzung nicht umgesetzte polymerisierbare funktionelle Gruppen in der Schicht. Rissbildung tritt bei der Vernetzung insbesondere dann auf, wenn die Vernetzungsreaktion von einer großen Volumenschrumpfung des Materials begleitet wird.

15

20

10

5

Der Umfang der Volumenschrumpfung hängt unter anderem von der Art der eingesetzten polymerisierbaren Funktion und/oder von der Struktur der noch nicht vernetzten Verbindung ab. Von der Art und/oder der Reaktivität der bei der Vernetzung eingesetzten polymerisierbaren funktionellen Gruppe hängt insbesondere auch ab, wie hoch die Konzentration dieser Gruppe nach der Vernetzung im Material ist und/oder wie sich nicht umgesetzte Gruppen bei der Anwendung in der OLED-Anordnung auswirken.

25

30

35

In den literaturbekannten Anwendungen konnte durch die Vernetzung auf dem Substrat bisher keine Verbesserung der OLED-Eigenschaften erreicht werden. Mögliche Gründe hierfür wurden gerade aufgeführt, beispielsweise Rißbildung. Gerade bei der elektrischen und/oder optischen Anwendung können nicht umgesetzte polymersierbare Gruppen aber auch als Störstellen fungieren, die die Effektivität und/oder die Lebensdauer einer derartigen Anordnung stark herabsetzen. Daher wirken sich zu geringe Umsätze und/oder zu langsame Reaktionsgeschwindigkeit der eingesetzten polymerisierbaren funktionellen Gruppe gerade bei elektrischen und/oder optischen Anwendungen äußerst negativ aus.

PCT/DE01/03346 WO 02/21611

3

So spielt bei einer auf einem elektrischen und/oder optischen Prozess basierenden Anordnung wie einer OLED, in der eine vernetzte Schicht enthalten ist, die Art der bei der Vernetzung eingesetzten polymerisierbaren Gruppe eine enorm wichtige Rolle.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, ein organisches halbleitendes Material zu schaffen, das eine funktionelle Gruppe hat, die eine Erhöhung der Glasübergangstemperatur der unvernetzten Verbindung auf dem Substrat durch Ver-10 netzung und eine gute Verarbeitbarkeit als Mehrschichtsystem bewirkt, wobei der Halbleiter die oben genannten Nachteile bei der Vernetzung auf dem Substrat wie Rissbildung durch Volumenschrumpfung, geringe Reaktionsgeschwindigkeit und unvollständige Umsetzung nur in geringem Umfang zeigt. Außerdem 15 ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung einer halbleitenden und/oder lumineszierenden Schicht anzugeben, wobei die Herstellung und die Synthese der Materialien durch metallkatalysefreie Synthesemethoden erfolgt, da Spuren von Metallkatalysatoren in den Materialien deren Lumi-20 neszenz stark gefährden.

Gegenstand der Erfindung ist eine oxetan-funktionalisierte niedermolekulare, oligomere oder (pre)polymere Verbindung, die halbleitende und/oder lumineszierende Eigenschaften hat und durch thermische Behandlung und/oder durch Bestrahlung vernetzbar ist.

Zudem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer oxetan-funktionalisierten Verbindung durch Kondensation und/oder HX-Eliminierung nach folgendem allgemeinen Reaktionsschema:

4

wobei für Het, Z, R, X, n und m gilt:

Het sind die heterocyclischen Grundkörper der ladungstransportierenden Verbindungen,

Z sind die Substituenten R³ und/oder R⁴ der heterocyclischen Grundkörper, die unabhängig voneinander oder beide eine Funktion tragen, die zur Anknüpfung an den Spacer R geeignet ist, vorzugsweise sind dies Hydroxyphenyl- oder Aminophenylgruppierungen,

die Gruppe der einsetzbaren Spacer R umfasst verzweigte oder unverzweigte, unsubstituierte Alkylenketten, vorzugsweise  $C_1$  bis  $C_8$ -Ketten, und/oder etherhaltige Alkylenketten und/oder

15 aromatenhaltige Alkylenketten.

 ${\bf X}$  ein Halogen oder OH, je nach dem angewandten Reaktionstyp zur Verknüpfung von  ${\bf Z}$  mit  ${\bf R}$  und

die Gruppe Z-Het ist ausgewählt aus der Gruppe, die folgende Verbindungen umfasst:

20

10

2-Aminothiophenderivate II und IIa

5-akzeptor-funktionalisierte 2-N, N-Diarylamino-thiophene IV 2,3-Bishtienylchinoxaline VII

1,4-Bis-1,1'-dithienyl-2,2'-diaryl-bzw.-2,2,2',2'-tetraaryl-

25 styrylbenzene IX

1,1-Dithienyl-2,2-diakzeptor-funktionalisierte Ethylene X
1-Thienyl-1-methyl-2,2-diakzeptor-funktionalisierte Ethylene
XI und

4,6-bisthienyl-funktionalisierte 1,3,2-Dioxaborine XII.

30 Der Parameter n ist 1 für die vernetzungsfähigen monomeren Verbindungen und kann aus reaktionskinetischen Gründen für die oligomeren und polymeren Verbindungen maximal 100 errei-

Der Parameter m kann 1 oder 2 sein.

5 Zudem sind Gegenstände der Erfindung Polymere mit der allgemeinen Struktur

für diese die Symbole R, Z und Het die oben angeführte Bedeutung besitzen, wobei das Symbol  $R^1$  im Baustein Het zwingend die angegebene bifunktionelle Bedeutung hat; der Polymerisationsgrad n, der durch die Stufenkondensation bedingt einen Wert von n=2 bis n=100 erreichen kann und der Parameter m, der den Wert von 1 oder 2 annehmen kann.

Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer halbleitenden und/oder lumineszierenden Schicht, bei dem eine oxetan-funktionalisierte Verbindung vernetzt wird.

Oxetane zeichnen sich durch hohe Reaktionsgeschwindigkeiten und/oder hohe Umsätze bei der Vernetzung in Substanz aus und/oder unterscheiden sich von anderen funktionellen Gruppen durch extrem niedrige Volumenschrumpfung während der Vernetzung. Die Inertheit der Oxetangruppe gegenüber stark basischen Reaktionsbedingungen ermöglicht ferner einen guten synthetischen Zugang zu neuen organischen Halbleitern mit ladungstranportierenden und/oder lumineszierenden Eigenschaften die peripher durch mindestens eine Oxetangruppe substituiert sind. So können beispielsweise oxetanfunktionalisierte Edukte in effektiven Synthesen problemlos eingesetzt werden.

5

10

15

20

25

Durch die Vernetzung auf dem Substrat erhöht die oxetanfunktionalisierte Verbindung ihre Glasübergangstemperatur und/oder wird unlöslich, so dass ein Mehrschichtaufbau für eine OLED, die bei Betriebstemperaturen oberhalb 100°C arbeitet, herstellbar ist.

Die Vernetzung der Oxetane erfolgt nach einem kationischen Mechanismus und wird bevorzugt durch thermische Initiatoren, z.B. thermisch latente Lewis-Säuren, und/oder durch Photoinitiatoren durch Bestrahlung mit aktinischer Strahlung der Wellenlänge 200nm bis 600nm, z.B. Photosäuren, initiiert.

Dabei kann das Oxetan an den niedermolekularen Halbleiter und/oder an das Polymerrückrat und/oder an die Seitenkette eines Halbleiters unmittelbar und/oder über einen Spacer kovalent angebunden sein. Die Ladungstransportverbindung kann eine niedermolekulare, oligomere und/oder polymere Verbindung sein. Der Grundkörper der bevorzugten oxetanfunktionalisierten Verbindung basiert auf heterocyclisch substituierten tertiären aromatischen Aminen, die durch bekannte Kondensationsreaktionen nach einem Baukastenprinzip darstellbar sind und aufgrund ihres Substitutionsmusters Elektronen oder Löcher transportieren können und zur Elektrolumineszenz im Bereich des sichtbaren elektromagnetischen Spektrums befähigt sind. Zur Steigerung der Lumineszenz in den OLEDs sind weiterhin alle, aus Laseranwendungen bekannten Fluoreszenzfarbstoffe prinzipiell einsetzbar.

Bevorzugt eingesetzt werden als oxetan-funktionalisierte Ver-30 bindungen die Ladungstransportmaterialien (Charge Transport Materials) CTM, welche durch die folgende Struktur charakterisiert sind: WO 02/21611 PCT/DE01/03346

. .7

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

CTM

für die folgendes gilt:

10

15

20

25

5 Het sind die heterocyclischen Grundkörper der ladungstransportierenden Verbindungen,

Z sind die Substituenten R³ und/oder R⁴ der heterocyclischen Grundkörper, die unabhängig voneinander oder beide eine Funktion tragen, die zur Anknüpfung an den Spacer R geeignet ist, vorzugsweise sind dies Hydroxyphenyl- oder Aminophenylgruppierungen,

die Gruppe der einsetzbaren Spacer R umfasst verzweigte oder unverzweigte unsubstituierte Alkylenketten, vorzugsweise  $C_1$  bis  $C_8$ -Ketten, und/oder etherhaltige Alkylenketten und/oder aromatenhaltige Alkylenketten,

 ${\bf X}$  ist Halogen oder OH, je nach angewandten Reaktionstyp zur Verknüpfung von  ${\bf Z}$  mit  ${\bf R}.$ 

Bevorzugt werden die ladungstransportierenden heterocyclischen Materialien Z-Het (II; IIa; IV; VII; IX; X; XI; und XII) in einfachen Syntheserouten sämtlich aus Thiocarbonsäureamiden des Typs I gemäß dem folgenden Reaktionsschema zugänglich, eingesetzt, die einen Polymerisationsgrad n, der durch die Stufenkondensation bedingt einen Wert von n=2 bis n=100 erreichen können und deren Parameter m, den Wert von 1 oder 2 annehmen kann.

Reaktionsschema:

a)

b)

5

$$\begin{array}{c}
R^{8} \\
R^{1} \\
R^{2} \\
R^{4} \\
R^{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{2} \\
R^{4} \\
R^{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{2} \\
R^{5} \\
R^{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{2} \\
R^{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{2}
\end{array}$$

Synthesebeschreibung:

- a) Synthese der Lochtransportmaterialien II und IIa: Aus den Thiocarbonsäureamiden des Typs I und den 2-Halo-5 genacylverbindungen Ia synthetisiert man die N,N-disubstituierten 2-Aminothiophenderivate II durch eine Hantzsch-analoge Alkylierungs- und Kondensationsreaktion. Aus den 5-unsubstituierten 2-Aminothiophenderivaten II werden die 5,5'-Bisthienylderivate IIa durch Oxydation a-10 ber auch durch lithium-organische Kupplungsreaktionen erhalten.
- b) Die orange bis rot emittierenden Elektronentransportmate-15 rialien IV werden erhalten, wenn man bei der Hantzschanalogen Reaktion 2-Halogenacylverbindungen Ia mit dem Substituenten  $R^5=H$  einsetzt. Die sich dabei bildenden Materialien des Typs II werden durch eine Vilsmeier Reaktion in die N,N-disubstituierten 2-Amino-5-formyl-thiophene III 20

WO 02/21611 PCT/DE01/03346

10

überführt, die danach in einem weiteren Kondensationsschritt mittels methylen-aktiver Verbindungen zu hocharylierten Emittern des Typs IV reagieren.

- 5 c) Die Thiocarbonsäureamide I sind gleichzeitig Edukte zur Bildung von vinylogen Thiocarbonsäureamiden V, aus welchen weitere Emittermaterialien zugänglich sind.
- d) Diese Verbindungen V können mit 1,4-Dibrombutan-2,3-dion zu 1,2-Diketonen des Typs VI umgewandelt werden. Aus diesen wiederum erhält man bei der Reaktion mit o-Aminoarylverbindungen einen neuen gelb bis orangen Emittertyp, die 2,3-Bisthienylchinoxaline VII.
- e) Durch Umsetzung der Verbindungen des Typs V mit 1,4Dibromacetylbenzen bilden sich die Diketone des Typs VIII.

  In einer Horner-Wittig Reaktion mit Derivaten, die durch eine Michaelis-Arbusov Reaktion zugänglich sind, entstehen aus den Ketonen VIII blaue bis gelbe Emittermaterialien des Typs IX.
  - f) In einer Reaktion der vinylogen Thiocarbonsäureamide  ${\bf V}$  mit 1,1-Dihalomethyl-2,2-diakzeptor-substituierten Ethylenen erhält man rot emittierende Emittermaterialien des Typs  ${\bf X}$ .
  - g) Ebenfalls orange bis rot emittierende Emittermaterialien XI werden beim Umsatz von Verbindungen des Typs V mit 1-Halomethyl-1-methyl-2,2-diakzeptor-substituierten Ethylenen erhalten.

25

30

35

h) Aus den Verbindungen des Typs V können schließlich mit 1,5-Dichloracetylaceton und anschließender Komplexierung mittels Borsäurederivaten die hocheffizient rot emittierenden Emittermaterialien des Typs XII, die 4,6-bisthienyl-substituierten 1,3,2-Dioxaborine erschlossen werden.

Die variablen Substituenten der im Reaktionsschema auftretenden Zwischen- und Endprodukte haben die folgende Bedeutung: R1, R2, und R5 sind - unabhängig voneinander - jeweils ein monofunktionelles (Het)arylsystem, d.h. ein konjugiertes carbocyclisches oder heterocyclisches Ringsystem, das auch aus linear oder angular anellierten oder verknüpften gleichen oder unterschiedlichen Ringtypen bestehen kann, wobei die peripheren Wasserstoffatome gegebenenfalls durch Alkyl-, Alkoxy-, Phenoxy-, Dialkylamino- oder Diphenylamiogruppen (Alkyl =  $C_1$ bis C<sub>6</sub>) substituiert sein können; 10 folgende (Het)arylsysteme sind dabei bevorzugt: Phenyl-, Biphenyl-, Alkylphenyl-, Alkoxyphenyl-, Phenoxyphenyl-, Naphthyl-, Anthryl-, Phenanthryl-, 4-Tritylphenyl-, Thienyl, - Thiazolyl-, Benzothiazolyl-, Pyridyl-, Chinolyl-, Isochinolyl-, Pyridazinyl-, Pyrimidinyl-, Chinazolyl-, Pyra-15 zinyl-, Chinoxalyl-, Phenazinyl- und Pyrenylsysteme.

R1 kann ferner ein entsprechendes bifunktionelles (Het)arylensystem sein, d.h. ein konjugiertes carbocyclisches oder 20 heterocyclisches Ringsystem, das auch aus linear oder angular anellierten oder verknüpften gleichen oder unterschiedlichen Ringtypen bestehen kann, wobei die peripheren Wasserstoffatome gegebenenfalls durch Alkyl-, Alkoxy-, Phenoxy-, Dialkylamino- oder Diphenylaminogruppen (Alkyl =  $C_1$  bis  $C_6$ ) 25 substituiert sein können; folgende (Het)arylensysteme sind dabei bevorzugt: Phenylen-, Biphenylen-, Alkylphenylen-, Alkoxyphenylen-, Phenoxyphenylen-, Naphthylen-, Anthrylen-, Phenanthrylen-, Thienylen, - Thiazolylen-, Pyridazinylen-, Phthalazinylen- und Pyrazinylensysteme. 30 R1 und R2 kann auch gemeinsam eine 10-Phenothiazinyl-, 10-Phenoxazinyl oder 9-Carbazolylgruppierung bilden.

R<sup>5</sup> kann ferner H sein.

35 Ausschließlich in Verbindung IIa hat R<sup>5</sup> die Bedeutung einer chemischen Bindung.

WO 02/21611

 $R^3$  und  $R^4$  entsprechen der oben erklärten Variablen Z, für den Fall, dass  $R^3$  oder  $R^4$  nicht der funktionalisierbaren Variablen Z entspricht hat dieser Substituent die Bedeutung von  $R^2$  oder Wasserstoff.

12

PCT/DE01/03346

- 5 R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup>, die gleich oder verschieden sein können, aber einfache oder komplexer gebaute Gruppierungen mit Elektronenakzeptorcharakter darstellen, die man gemeinsam mit dem beide Substituenten verbindenden C-Atom sämtlich als von der Malonsäure sowie deren cyclischer Ureide und Thioureide abgeleitete Gruppierungen auffassen kann; demnach R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> Nitril-Gruppierungen, Carbonsäureestergruppierungen, und Carbonsäureamid-gruppierungen sein können, wobei die Ester-Amid-bzw. Ureidreste verzweigte oder unverzweigte Alkylreste mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen umfassen können, 4-Triphenylmethyl-
- 15 phenylreste (4-Tritylphenylreste) sowie  $R^2$  sein können.

 $R^8$  und  $R^9$  sind  $C_4$ - bis  $C_{10}$ -Alkylgruppierungen oder bilden gemeinsam eine  $C_4$ - bis  $C_6$ -Alkylengruppierung oder eine Gruppierung - $CH_2$ - $CH_2$ -O- $CH_2$ - $CH_2$ -.

20

 $R^{10}$  und  $R^{11}$  haben unabhängig voneinander die Bedeutung von  $R^2$ , ferner kann einer der beiden Substituenten auch H sein.  $R^{10}$  und  $R^{11}$  können auch mit dem beide Substituenten verbindenden Kohlenstoffatom einen 9-Fluorenvlidenrest bilden.

25

30

Y kann Kohlenstoff oder Stickstoff sein. Für den Fall, dass Y=C ist können unabhängig voneinander an den Bindungen c, d und e weitere aromatische Ringstrukturen anelliert sein; Für den Fall, dass Y=N ist können an der Bindung d weitere aromatische Ringstrukturen anelliert sein und schließlich die

Komplexliganden L die, unabhängig voneinander gleich oder verschieden sein können, stehen für Halogen, dabei vorzugs-weise Fluor, Alkyl- oder Aryloxy, wobei die Alkylgruppierungen verzweigt oder unverzweigt 1 bis 20 C-Atome und verschiedene funktionelle Gruppen mit N, O und/oder S enthalten können oder beide gemeinsam, durch einen zumindest zweizähnigen

WO 02/21611 PCT/DE01/03346

13

Liganden mit dem Boratom einen Cyclus bilden, wobei der zumindest zweizähnige Ligand Hydroxy- und/oder Carbonsäuregruppen haben kann und vorzugsweise ein Diol, eine Hydroxycarbonsäure oder eine Dicarbonsäure, wie  $-OC_2H_4O^-$ ,  $-OC_3H_6O^-$ , Glykolat, Laktat, Tartrat, Sylicylat, Mandelat, Benzilat, 1,2- oder 2,3-Hydroxynaphthoat, Oxalat, Malonat, Alkylmalonat oder Dialkylmalonat ist.

Die Anbindung des Spacers R kann demnach bevorzugt über Phe-10 nolether, Benzylether, Phenolthioether und/oder tertiäre Amine (aliphatisch und/oder aromatisch) erfolgen.

Ein besonderer Vorteil der oben beschriebenen Synthese der Materialien für die halbleitende und/oder lumineszierende Schicht sowie der Herstellungsmethode für die Schicht selbst ist, dass in keinem Verfahrens(teil)schritt eine Metallkatalyse erforderlich ist. Der Einsatz von metallkatalysierten Verfahrens(teil)schritten führt häufig zu einem Verlust oder zur Zerstörung der lumineszierenden Eigenschaften.

20

25

15

Die Länge und/oder Art der eingesetzten Spacer beeinflussen die Materialeigenschaften wie beispielsweise Glasübergangstemperatur, Filmbildungseigenschaften, Kristallisationsverhalten, Löslichkeit, Reaktivität und/oder der maximal erreichbare Umsatz der unvernetzten Verbindungen. Im Netzwerk können unter anderem die Ladungstransporteigenschaften und/oder die Materialeigenschaften über die Spacereigenschaften variiert und/oder optimiert werden.

Die Materialeigenschaften der unvernetzten Verbindungen sind von besonderer Wichtigkeit für die Verarbeitbarkeit. Insbesondere die Löslichkeits-, Filmbildungs- und/oder Kristallisationseigenschaften und/oder die Glasübergangstemperatur. Deshalb können niedermolekulare und/oder oligomere und/oder polymere oxetanfuntionalisierte Ladungstransportverbindungen verwendet werden. Ausdrücklich seien auch dimere Verbindungen erwähnt, in denen zwei ladungstransportierende Verbindungs-

WO 02/21611

5

10

15

20

25

14

PCT/DE01/03346

teile über Brücken verbunden sind. Mit denselben Gruppen kann man auch zu höheren Homologen gelangen.

Neben zwei- und mehrfach oxetanfunktionalisierten niedermolekularen Ladungstransportverbindungen können auch einfach
funktionalisierte niedermolekulare Ladungstransportverbindungen zu den mehrfach funktionalisierten Verbindungen zugesetzt
werden. Diese Verbindungen umfassen einen und/oder mehrere
ladungstransportierende Verbindungsteile, an die nur eine
Oxetanfunktion kovalent angebunden ist. Diese einfach oxetanfunktionalisierten Ladungstransportverbindungen wirken als
Reaktivverdünner und können durch ihre höhere Mobilität zu
hohen Umsätzen an Oxetan führen und somit zur Umsatzmaximierung beitragen, ohne die Konzentration der Ladungstransportverbindungen im Netzwerk herabzusetzen.

Die einfach oxetanfunktionalisierten Ladungstransportverbindungen können auch durch Verwendung von polymeren und/oder nierdermolekularen mehrfach oxetanfunktionalisierten Verbindungen, die keine ladungstransportierenden Eigenschaften besitzen und/oder als Vernetzer wirken, in ein Netzwerk eingebunden werden. Es tragen insbesondere polymere Vernetzer zur Verbesserung der Filmbildungseigenschaften der noch unvernetzten Schichten bei. Die polymeren Vernetzer können aus einem Polymerrückrat bestehen, das beispielsweise aus Polystyrol, Poly $(\alpha$ -methyl-styrol), Polyacrylat, Polymethacrylat, Polyester, Polyamid und/oder Polysulfonat besteht, und teilweise und/oder vollständig oxetansubstituiert ist.

Die Erfindung umfasst auch oxetanfunktionalisierte ladungstransportierende Polymere. Diese Polymere eignen sich wegen
ihrer guten Filmbildungseigenschaften ebenfalls zur Schichtenpräparation für OLED-Anordnungen. Auch Kombinationen von
oxetanfunktionalisierten niedermolekularen Ladungstransportverbindungen und oxetanfunktionalisierten polymeren Ladungstransportverbindungen in einer oder mehreren Schichten sind
möglich.

WO 02/21611 PCT/DE01/03346

15

Zur Herstellung der halbleitenden und/oder lumineszierenden Schicht wird ein-geeignetes Substrat (z.B. Glas, Folie, unlösliches organisches transparentes Material) durch ein Verfahren aus Lösung und/oder aus Substanz mit der oxetanfunktionalisierten Verbindungen beschichtet, vorzugsweise durch Spin-coating oder Rakeln aus verdünnter Lösung. Die Lösung umfasst neben der oxetan-funktionalisierten Verbindung optional weitere Komponenten, wie Bindemittel, Reaktivverdünner, Vernetzer und/oder thermischen Initiator und/oder Photoinitiator. Nach eventueller Trocknung wird der entstandene Film thermisch und/oder mit aktinischer Strahlung polymerisiert und/oder vernetzt. Anschließend kann sogleich die nächste Schicht aufgebracht werden. Durch die Vernetzung bildet sich ein unlösliches kovalentes Netzwerk aus, bei dem auch bei Auftragung der nächsten Schicht aus Lösung (z.B. Spin-coating, Rakeln) und/oder aus Substanz keine Vermischung der bereits aufgetragenen Schicht mit der frisch aufgetragenen Schicht auftritt.

20

25

30

10

15

Mittels strahlungsinduzierter Vernetzung können die Schichten bzw. die Schicht durch bildgemäßes Belichten natürlich auch strukturiert werden. Dies dient erfindungsgemäß insbesondere für die Auftragung der verschiedenden Emittermaterialien für vollfarbige und/oder mehrfarbige Displayanwendungen zur Farbpixelierung der Displays. Eine Kombination von vernetzten Schichten mit unvernetzten Schichten, die durch Aufdampfen, Spin-coating oder Rakeln aufgetragen werden, ist natürlich auch möglich. Hier werden in der Regel bis auf die jeweils letzte alle anderen Schichten zuvor vernetzt worden sein.

Als Lösungsmittel eignen sich insbesondere cyclische Ether, wie z.B. substituierte Epoxide, substituierte und/oder unsubstituierte Oxetane und/oder Tetrahydrofuran.

35

Diese cyclischen Ether können für den Fall, dass das Lösungsmittel nicht vollständig durch Evakuieren entfernt werden 10

15

20

25

30

kann, an der Vernetzungsreaktion als Reaktivverdunner mitwirken und somit zur Erhöhung des Umsatzes und/oder des Vernetzungsgrades der hergestellten Schichten beitragen, d.h. die Lösungsmittelreste werden als Co-Monomer im Laufe der Polymerisation bzw. Vernetzungsreaktion in das entstehende Polymer bzw. das Polymernetzwerk eingebaut.

Manche der oxetanhaltigen Verbindungen sind flüssig und/oder ölig und müssen daher nicht unbedingt in Lösungsmitteln gelöst werden, sondern können auch pur und/oder in Mischungen aus mehreren Monomeren ohne Lösungsmittel aufgetragen werden. Diese Mischungen können außerdem kationischen Initiator, Bindemittel, Reaktivverdünner und/oder zusätzliche Vernetzer umfassen und z.B. durch Spin-coating und/oder Rakeln zu Schichten verarbeitet werden. Die Verwendung der beschriebenen Schichten eignet sich auch zur Herstellung dickerer Schichten von über 10μm. Eine Verarbeitung kann beispielsweise auch durch Spritzgießen, durch Nutzung von Drucktechniken und/oder sogenannten "real to real"-Techniken erfolgen. Die erhaltenen Schichten sind thermisch stabil, unlöslich und mechanisch belastbar. Je nach gewünschter Ausführung können analog weitere Schichten oder sofort die zweite Elektrode aufgebracht werden. Derartige Schichtanordnungen zeichnen sich durch eine besonders gute thermische Belastbarkeit, hohen amorphen Charakter und Unlöslichkeit aus.

Die erfindungsgemäßen Schichten eignen sich insbesondere durch die Möglichkeit der Strukturierung der organischen Schichtmaterialien (z.B. thermisch und/oder Photostrukturierung) zum Aufbau von OLEDs ohne die Strukturierung mit Photolackschichten und/oder andere Hilfsbeschichtungen anwenden zu müssen.

Die Schichtdicken können je nach Anwendung von einigen Nano-35 metern, bis hin zu Millimetern variieren. Ein bevorzugter Bereich ist von 25 bis 250 nm Schichtdicke. Beim Aufbau von OLEDs resultierten mit Schichtdicken unter 90 nm die effi-

PCT/DE01/03346

WO 02/21611

zientesten Anordnungen. Die Schichtdicke kann aber auch jeweils kleiner als die angegebene Untergrenze und/oder größer als die angegebene Obergrenze sein.

17

5 Ausführungsbeispiele:

Zur analytischen Kontrolle wurden die synthetisierten Verbindungen durch NMR-Spektroskopie sowie durch ESI-Massenspektroskopie untersucht. Die UV/Vis- und fluoreszenzspektroskopischen Untersuchungen wurden in THF durchgeführt.

10

## a) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der Thioamide I

In einem 2 1-Dreihalskolben mit Rückflusskühler, Magnetrührer, Tropftrichter und Inertgasdurchfluss wird jeweils 1 mol eines sekundären aromatischen Amins entsprechend der 15 Substituentendefinition in 600 ml Dioxan gelöst. Das benötigte gemäß des Substituentenschlüssels substituierte Essigsäurechlorid, hier beispielhaft mit 4-0-Acetylphenyl-essigsäurechlorid, wird zuvor aus 4-O-Acetylphenylessigsäure und Thionylchlorid dargestellt, das überschüssige Thionylchlorid im 20 Vakuum entfernt und danach in äquivalenter Menge der Aminlösung zugetropft. Anschließend wird das Reaktionsgemisch unter Rückfluss erhitzt, bis die gesamte Menge des bei der Reaktion entstehenden Chlorwasserstoffes vom Inertgasstrom entfernt worden ist. Durch dünnschichtchromatographische Kontrolle 25 kann das Ende der Reaktion zusätzlich detektiert werden. Die Reaktionslösung wird dann abgekühlt und mindestens in das doppelte Volumen Eiswasser eingerührt. Dabei scheidet sich in den meisten Fällen ein Öl ab, welches mitunter erst nach einigen Stunden beim Rühren erstarrt. Die wässrige Phase wird 30 abgetrennt und das Rohprodukt aus Acetanhydrid umkristallisiert.

Das auf diese Art erzeugte Carbonsäureamid wird wie folgt in ein Thioamid umgewandelt

0,5 mol des jeweiligen Carbonsäureamids und die äquivalente Menge Lawesson-Reagenz (hergestellt aus Anisol und Phosphorpentasulfid) werden in einer Rückflussapparatur mit Inertgasdurchfluss in 500 ml Dioxan suspendiert, und nachfolgend 6 h bei 100°C gerührt. Dabei bildet sich eine klare Lösung. Nach dünnschichtchromatographischer Kontrolle des Reaktionsendes wird die Reaktionsmischung in die doppelte Menge Wasser eingerührt, die sich oft bildende ölige Phase lässt man dann kristallisieren. Danach wird das Produkt von der wässrigen Phase abgetrennt und aus Acetanhydrid umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt bezogen auf das Amin jeweils mindestens 60%. Beispiel 1

10 Auf diese Art wird das Thiocarbonsäureamid I/1 ( $R^1 = R^2 = Phenyl$ ,  $R^3 = 4-0$ -acetylphenyl)  $M^4 = 361$  hergestellt.

Beispiel 2

Auf diese Art wird das Thiocarbonsäureamid I/2 ( $R^1 = 1,4-15$  Phenylen,  $R^2 = Phenyl$ ,  $R^3 = 4-0$ -acetylphenyl)  $M^4 = 644$  hergestellt.

20

b) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der Aminothiophenderivate II

0,1 mol des jeweiligen Thiocarbonsäureamids I werden in einem Kolben, der mit Rührer und Rückflusskühler versehen ist, zusammen mit der äquivalenten Menge einer  $\alpha$ -Halogen-

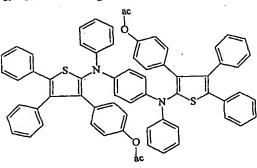
25 acylverbindung Ia in 200 ml Acetanhydrid gelöst, dann wird 1 h auf 120°C erwärmt. Nach dem Abkühlen wird das gebildete Aminothiophen-Derivat ausgefällt, indem es auf Eis gegossen wird und durch absaugen isoliert. Das Rohprodukt wird durch Lösen in THF und Ausfällen mit Ethanol gereinigt. Die Ausbeute beträgt jeweils zwischen 60 und 80%.

Beispiel 3

5 Auf diese Art wird das Thiophen-Derivat II/1 ( $R^1 = R^2 = Phe$ nyl,  $R^3 = 4$ -O-acetylphenyl,  $R^4 = Phenyl$ ,  $R^5 = H$ )  $M^+ = 461$ ) aus dem Thiocarbonsäureamid I/1 ( $R^1 = R^2 = Phenyl R^3 = 4-O$ acetylphenyl) und Phenacylchlorid hergestellt.

Beispiel 4 10

Auf diese Art wird das Thiophen-Derivat II/2 ( $R^1 = 1,4$ -Phenylen,  $R^2$  = Phenyl,  $R^3$  = 4-0-acetylphenyl,  $R^4$  =  $R^5$  = Phenylen, nyl)  $M^+$  = 996 aus dem Thiocarbonsäureamid I/2 ( $R^1$  = 1,4 Phenylen,  $R^2$  = Phenyl  $R^3$  = 4-0-acetylphenyl) und Desylchlorid  $(\alpha-Chlor-\alpha-phenylacetophenon)$  hergestellt.



c) Allgemeine Vorschrift zur Synthese von dimeren bzw. polymeren Aminothiophen-Derivaten IIa (durch oxidative Kupplung)

20

25

15

0,01 mol eines in 5-Stellung unsubstituierten Thiophen-Derivates II werden in einem Kolben, der mit Rückflusskühler, Rührer, Feststoffdosiereinrichtung und Inertgasdurchfluß versehen ist, in 100 ml getrocknetem THF gelöst. Es wird auf -60°C abgekühlt, und dann werden 0,015 mol Butyllithium

zugesetzt. Anschließend wird die Kühlung entfernt und man lässt das Reaktionsgemisch bis auf -10°C auftauen. Nachfolgend werden mittels der Feststoffdosiereinrichtung 0,011 mol Kupfer-II-chlorid zugefügt, und dann wird weiter bis auf 40°C erwärmt. Die Reaktion wird nach 30 min abgebrochen, indem das Produkt mit Wasser (bei Polymeren mit Methanol mit einem Zusatz von 10% Wasser) ausgefällt und danach abgesaugt wird. Durch mehrfaches Lösen in THF und Ausfällen mit Methanol wird das Produkt gereinigt. Bei nichtpolymeren Verbindungen ist die Reinigung auch durch Umkristallisation aus Acetanhydrid möglich.

Beispiel 5

Auf diese Art wird das dimere Thiophen-Derivat IIa/1 ( $R^1 = R^2 = R^4 = Phenyl$ ,  $R^3 = 4-0$ -acetylphenyl)  $M^+ = 920$  aus Verbindung II/1 hergestellt.

## d) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der 2-Amino-5-formylthiophene III

20

25

10

15

In einem 250ml Becherglas mit Rührer werden 0,02 mol) einer 5-unsubstituierten Verbindung des Typs II in 50ml Dimethylformamid gelöst. Unter Kühlung auf etwa 5°C werden anschließend langsam 0,025 mol Phosphoroxychlorid POCl<sub>3</sub> hinzugegeben, danach lässt man noch 30 min rühren und erwärmt dabei auf etwa 30°C. Nach beendeter Reaktion wird vorsichtig in Eiswasser gegossen, wobei gelbe Kristalle ausfallen.

Das Rohprodukt wird abgesaugt und aus Ethanol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt mindestens 50%.

30 Beispiel 6

Auf diese Art wird das 2-Amino-5-formyl-thiophene III/1

WO 02/21611

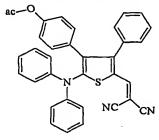
 $(R^1 = R^2 = R^4 = Phenyl, R3 = 4-O-acetylphenyl) M^+ = 489 aus Verbindung II/1 hergestellt.$ 

5

- e) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der 5-akzeptorsubstituierten 2-Aminothiophene IV
- In einem 250 ml Becherglas werden 0,01 mol eines 2-Amino-5formylthiophens III und 0,015 mol einer entsprechenden methylenaktiven Akzeptorverbindung in 30 ml Acetanhydrid suspendiert und anschließend für einige Minuten unter Zusatz einiger Tropfen Triehylamin zum Sieden erhitzt. Nach beendeter
- 15 Reaktion wird auf 100g Eis gegossen, wobei das Rohprodukt ausfällt. Es wird von der wäßrigen Phase abgetrennt und aus Acetanhydrid umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt mindestens 30%.

Beispiel 7

Auf diese Art wird das 5-akzeptor-substituierte 2-Aminothiophen IV/1 ( $R^1=R^2=R^4=Phenyl$ ,  $R^3=4-O-Acetylphenyl$ ,  $R^5=2,2-Dicyanovinyliden$ )  $M^4=537$ ,  $\lambda_{max}=485nm$ ,  $\lambda_{\Phi}=595$  nm aus Verbindung III/1 und Malonsäuredinitril hergestellt.



25 Beispiel 8

Auf diese Art wird das 5-akzeptor-substituierte 2-Aminothiophen IV/2 ( $R^1 = 1,4$ -Phenylen,  $R^2 = R^4 = Phenyl, R3 = 4-0-$  5

Acetylphenyl, R5 = N,N'-Diphenyl-5,5-vinyliden-thiobarbitursäure M' = 1456,  $\lambda_{max}$  = 520nm,  $\lambda_{\Phi}$  = 618 nm aus der entsprechenden 5,5'Bisformylverbindung des Typs III und N,N'-Diphenylthiobarbitursäure hergestellt.

f) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der vinylogen Thiocarbonsäureamide V

In einem 0,5 l-Kolben mit Rückflusskühler, Heizeinrichtung und Rührer werden 0,15 mol 2-0-Acetylphenyl-thioessigsäure-phenyl-1-naphthylamid zusammen mit der 4-fach äquivalenten Menge Morpholin und 4-fach äquivalenten Menge Orthoameisensäuretriethylester für 7h auf 125°C erwärmt. Nach beendeter Reaktion lässt man abkühlen und verdünnt mit Methanol wobei gelbe Kristalle ausfallen, die dann abgesaugt werden. Das Rohprodukt wird in Ethanol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt mindestens 60%.

Beispiel 9

Auf diese Art wird das vinyloge Thiocarbonsäureamide V/1 (R1 = Phenyl, R2 = Naphthyl, R3 = 4-0-Acetylphenyl, R8,R9 bilden mit dem Stickstoff Morpholin M = 508 aus dem entsprechenden Thiocarbonsäureamid des Typs I, Orthotriethylformiat und Morpholin hergestellt.

Auf diese Art wird das vinyloge Thiocarbonsäureamide V/2 ( $R^1 = 1,4$ -Phenylen,  $R^2 = Phenyl$ ,  $R^3 = 4$ -O-Acetylphenyl,  $R^8$ ,  $R^9$  bilden mit dem Stickstoff Morpholin  $M^+ = 838$  aus dem entsprechenden Thiocarbonsäureamid des Typs I, Orthotriethylformiat und Morpholin hergestellt.

g) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der Bisthienyl-1,2dicarbonyl-verbindungen VI

In einem Kolben mit Rückflusskühler, Heizeinrichtung und Rührer werden 0.02 mol vinyloges Thiocarbonsäureamide V, 0,012 mol 1,4-Bibrombutan-2,3-dion und 60ml Acetanhydrid suspendiert und eine Stunde am Rückfluß erhitzt. Danach wird abgekühlt, abgesaugt und getrocknet. Ausbeute beträgt mindestens 60%.

Beispiel 11

10

15

Auf diese Art wird die Bisthienyl-1,2-dicarbonyl-verbindung 20 VI/1 ( $R^1$  = Phenyl,  $R^2$  = Naphthyl,  $R^3$  = 4-O-Acetylphenyl  $M^4$  = 924 aus V/1 und 1,4-Dibromdiacetyl hergestellt.

5

WO 02/21611

Auf diese Art wird die Poly-bisthienyl-1,2-dicarbonylverbindung VI/2 ( $R^1 = 1,4$ -Phenylen,  $R^2 = Phenyl$ ,  $R^3 = 4$ -O-Acetylphenyl aus V/2 und 1,4-Dibromdiacetyl hergestellt.

h) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der 5,6-annelierten 2,3-Bisthienyl-pyrazine VII

In einem Kolben mit Rückflusskühler, Heizeinrichtung und Rührer werden 0.02 mol Bisthienyl-1,2-dicarbonyl-verbindung VI, 0,012 mol 1,2-Phenylendiamin, 60ml Dimethylformamid und 1 ml konzentrierte Salzsäure suspendiert und eine Stunde am Rückfluß erhitzt. Danach wird abgekühlt, abgesaugt und ge-

trocknet. Ausbeute beträgt mindestens 60%. Die Chromophore fallen nach der Reaktion bereits in ihrer ungeschützten Form an.

Beispiel 13

Auf diese Art wird das 2,3-Bisthienyl-chinoxalin VII/1 ( $R^1=20$  Phenyl,  $R^2=1$  Naphthyl, R3 = 4-Hydroxyphenyl  $M^4=1$  912  $\lambda_{max}=1$  410 nm,  $\lambda_{\Phi}=1$  563 nm aus VI/1 und 1,2-Phenylendiamin hergestellt.

5

Auf diese Art wird das Poly-2,3-bisthienyl-chinoxalin VII/2  $(R^1 = 1, 4-Phenylen, R^2 = Phenyl, R3 = 4-Hydroxyphenyl aus$ VI/2 und 1,2-Phenylendiamin hergestellt.

# i) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der Arylketone VIII

0,1 mol des jeweiligen vinylogen Thiocarbonsäureamids V wer-10 den in einem Becherglas zusammen mit der äquivalenten Menge Dibromacetylbenzol in 150 ml Acetanhydrid 30 min unter Rühren auf 120°C erwärmt; dabei entsteht eine klare Lösung, aus der nach dem Erkalten das gebildete Arylketon VIII ausfällt. Die Reaktionsmischung wird abgesaugt, danach wird Produkt in THF 15 gelöst und in Methanol gefällt. Die Ausbeute beträgt jeweils mindestens 80%.

Beispiel 15

Auf diese Art wird das Aryklketon VIII/1 ( $R^1 = Phenyl$ ,  $R^2 =$ Naphthyl, R3 = 4-0-Acetylphenyl  $M^{+}$  = 1000 aus V/1 und 1,4-20 Dibromacetylbenzol hergestellt.

Auf diese Art wird das Poly-arylketon VIII/2 ( $R^1 = 1,4$ -Phenylen,  $R^2 = Phenyl$ ,  $R^3 = 4$ -O-Acetylphenyl aus V/2 und 1,4-Dibromacetylbenzol hergestellt.

## j) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der 1,4-Bisstyrylbenzenderivate IX

10

15

20

25

In einem Dreihalskolben, der mit Inertgasdurchfluss, Rückflusskühler und Feststoffdosiereinrichtung versehen ist, werden 0,01 mol des jeweiligen Aryklketon-Derivates VIII und die äquivalente Menge Phosphonsäureester in einem Gemisch aus 100 ml trockenem Toluol und 100 ml trockenem THF gelöst und bei 80°C gerührt. Danach wird zur Deprotonierung des Phosphonsäureesters jeweils die äquivalente Menge Kalium-tert.-butylat mittels der Feststoffdosiereinrichtung zugegeben. Gewöhnlich fällt dabei das Produkt bereits in der Wärme aus. Das Ende der Reaktion kann dünnschichtchromatographisch detektiert werden. Zur Aufarbeitung wird der Reaktionsmischung die 2fache Menge Methanol zugesetzt, und dann wird durch Zugabe von Eisessig neutralisiert. Anschließend wird das erhaltene Produkt abgesaugt, mit Methanol gewaschen und getrocknet. Durch Lösen in THF und wiederholtem Ausfällen mit Methanol wird das Produkt gereinigt. Die Rohausbeute des halbleitenden

Materials ist jeweils nahezu quantitativ. Ein Teil des Produktes liegt bereits in der Hydroxyform vor.

27

### Beispiel 17

Auf diese Art wird das 1,4-Bisstyryl-benzenderivat IX/1 ( $R^1$  = Phenyl,  $R^2$  = Naphthyl,  $R^3$  = 4-0-Acetylphenyl  $M^+$  = 1148,  $\lambda_{max}$  = 395nm,  $\lambda_{\Phi}$  = 479nm aus VIII/1 und Phenylmethanphosphonsäurediethylester hergestellt.

### 10 Beispiel 18

Auf diese Art wird das Poly-(1,4-Bisstyryl-benzen)-derivat IX/2 ( $R^1 = 1,4$ -Phenylen,  $R^2 = Phenyl$ ,  $R^3 = 4$ -O-Acetylphenyl aus VIII/2 und Phenylmethanphosphonsäurediethylester hergestellt.

#### 15

## k) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der 1,1-Bisthienyl-2,2bisakzeptorethylene X

In einem 100 ml Kolben mit Rührer, Heizeinrichtung und Rückflußkühler werden 0,005 mol 1,1-Di-(brommethyl)-2,2-dicyano-ethylen zusammen mit 0,01 mol des jeweiligen vinylogen Thiocarbonsäureamids V in 50 ml THF gelöst und für 10h am Rückfluß erhitzt. Nach beendeter Reaktion wird abgekühlt, vom entstandenen Nebenprodukt (Morpholiniumhydrobromid) abgesaugt und am Rotationsverdampfer eingeengt. Schließlich erfolgt

säulenchromatographische Reinigung des Produktes über Kieselgel. Die Ausbeute beträgt mindestens 40%.

Beispiel 19

Auf diese Art wird das 1,1-Bisthienyl-2,2-biscyanorethylene X/1 ( $R^1$  = Phenyl,  $R^2$  = Naphthyl,  $R^3$  = 4-O-Acetylphenyl  $M^+$  = 944,  $\lambda_{max}$  = 490nm,  $\lambda_{\Phi}$  = 612 nm aus dem vinylogen Thiocarbonsäureamid V/1 und 1,1-Di-(brom-methyl)-2,2-dicyano-ethylen hergestellt.

10

1) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der 5-akzeptorsubstituierten Aminothiophene XI

In einem 100 ml Kolben mit Rührer, Heizeinrichtung und
Rückflußkühler werden 0,012 mol 1-(Brommethyl)-1-methyl-2,2dicyano-ethylen zusammen mit 0,01 mol des jeweiligen vinylogen Thiocarbonsäureamids V in 50 ml THF gelöst und für 10h am
Rückfluß erhitzt. Nach beendeter Reaktion wird abgekühlt, vom
entstandenen Nebenprodukt (Morpholiniumhydrobromid) abgesaugt
und am Rotationsverdampfer eingeengt. Schließlich erfolgt
säulenchromatographische Reinigung des Produktes über Kieselgel. Die Ausbeute beträgt mindestens 40%.

Beispiel 20

Auf diese Art wird das 1-[2-(N-phenyl-N-1-naphthylamino-3-{4-25 O-acetyl}-phenyl)-thiophen-5-yl]-1-methyl-2,2-dicyano-ethylen XI/1 ( $R^1$  = Phenyl,  $R^2$  = Naphthyl,  $R^3$  = 4-O-Acetylphenyl  $M^4$  = 525,  $\lambda_{max}$  = 480nm,  $\lambda_{\Phi}$  = 590 nm aus dem vinylogen Thiocarbon-säureamid V/1 und 1-(Brommethyl)-1-methyl-2,2-dicyano-ethylen hergestellt.

## m) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der 4,6-Bisthienyl-1,3,2-Dioxaborine XII

Eine Mischung aus einem vinylogen Thiocarbonsäureamid V (0,002 mol) und 1,5-Dichlor-pentan-2,4-dion (0,001 mol) in Acetonitril (50 mL) wird 30min auf dem Wasserbad erwärmt. Das beim Erkalten nach Zugabe von Wasser (10 ml) ausfallende Produkt wird abgesaugt und an der Luft getrocknet. Eine Mischung des isolierten 1,3-Diketoderivats (0,001 mol) in Acetanhydrid (100 mL) wird mit einem Überschuß eines Borsäure-Derivates versetzt und anschließend 30 min unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Erkalten wird vom ausgefallenem Produkt abgesaugt und zur Reinigung aus Acetanhydrid umkristallisiert.

Beispiel 21

5

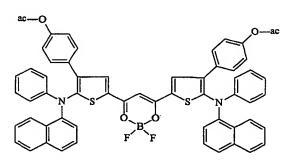
10

15

20

25

Auf diese Art wird das 4,6-Bisthienyl-1,3,2-Dioxaborine XII (R¹ = Phenyl, R² = Naphthyl, R3 = 4-O-Acetylphenyl M¹ = 986,  $\lambda_{max}$  = 570nm,  $\lambda_{\Phi}$  = 605nm aus dem vinylogen Thiocarbonsäureamid V/1, 1,5-Dichlor-pentan-2,4-dion und Bortrifuorid-Etherat hergestellt.



n) Allgemeine Vorschrift zur Entfernung der Schutzgruppen an den Chromophoren II, IIa, IV, VII, IX, X, XI und XII

PCT/DE01/03346

Beispiel 22

In einem Becherglas werden 0,01 mol des jeweiligen Chromophors in möglichst wenig DMF bei 50°C gelöst und nach Zugabe von 5 ml conc. Ammoniaklösung bei gerührt. Der Fortschritt der Reaktion wird dünnschichtchromatographisch kontrolliert. Sollte sich nach 30 min keine wesentliche Umsetzung vollzogen haben wird die Reaktionstemperatur schrittweise erhöht. Nach vollständigem Umsatz wird abgekühlt und in Methanol gefällt, mit Ammoniak neutralisiert, abgesaugt und getrocknet.

30

#### o) Synthese kupplungsfähiger Oxetanderivate

Beispiel 23

15 3-Ethyl-3-hydroxymethyloxetan:

In einem 11 Kolben werden 536g (4 mol) 1,1,1-Tris- (hydroxymethyl)-propan in 472g (4 mol) Diethylcarbonat durch Erwärmen gelöst. Anschließend werden 0,5g KOH gelöst in 20ml Ethanol zugegeben und die Reaktionsmischung 3h unter Rückfluß erhitzt. Durch Austausch des Kühlers durch einen Wasserabscheider wird danach der gebildete Alkohol vollständig abdestilliert. Abschließend destilliert man das Reaktionsprodukt im Vakuum.



25

30

35

20

10

Beispiel 24

3-Ethyl-3-chlormethyloxetan:

In einem Dreihalskolben mit Rückflußkühker und Inertgasdurchfluß werden 134g (1 mol) 1,1,1-Tris-(hydroxymethyl)-propan in 2 mol Pyridin gelöst. Unter Rühren und Kühlung werden langsam 2 mol Thionylchlorid zugetropft. Die Lösung wird danach für 12h am Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen fügt man der Lösung jeweils 400ml Wasser und Ether zu und trennt die Etherphase im Scheidetrichter ab. Dann wird die Etherphase mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, am Rotationsverdampfer eingeengt und das Produkt

1,1-Bis-(chlormethyl)-1-hydroxymethyl-propan schließlich am Vakuum destilliert.

0,5 mol dieser Verbindung werden in 250ml abs. Ethanol mit 28g KOH für 10h am Rückfluß gekocht. Nach dem Abkühlen filtriert man vom KCl ab, fügt dem Filtrat jeweils 100ml Wasser und Ether zu und isoliert die etherische Phase. Die Etherphase wird nun nochmals mit Wasser ausgeschüttelt, über Magnesiumsulfat getrocknet, der Ether abgezogen und abschließend der Rückstand im Vakuum destilliert.

CI

10

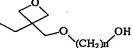
15

20

25

Beispiel 25

Allgemeine Vorschrift zur Veretherung des 3-Ethyl-3-chlormethyloxetans mit  $\alpha, \omega$ -Dihydroxyalkanen

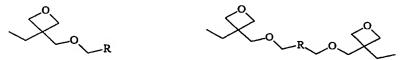


O (CH<sub>2</sub>)m OH

In einem Becherglas werden 0,5 mol eines  $\alpha, \omega$ -Alkandiols, 0,5 mol KOH, 0,05 mol KI und 0,5 mol 3-Ethyl-3-chlorethyl-oxetan gegeben und 6h auf 110°C erwärmt. Nach dem Abkühlen werden 350ml Ether zugegeben, vom Feststoff abfiltriert und der Filterrückstand mit 500ml Ether gewaschen. Nun wird der Ether am Rotationsverdampfer entfernt und das Produkt im Vakuum destilliert.

- i) Auf diese Art wird beispielsweise aus 1,6-Hexandiol und 3-Ethyl-3-chlormethyloxetan die folgende verlängerte Oxetanverbindung hergestellt.
- p) Allgemeine Vorschrift zur Synthese vernetzend wirkender Lösungsmittel / Verdünner

30 Beispiel 26



In einer Rückflußapparatur werden 120g 50%-ige NaOH, 120ml Hexan, 2g Tetrabutylammoniumbromid und 0,1 mol Chlormethyl-

10

bzw. Hydroxymethyloxetan-derivat vorgelegt. Zu dieser Mischung wird jeweils die äquivalente Menge einer entsprechenden Hydoxyalkyl- bzw. Halogenalkylverbindung zugefügt. (Im Falle des Einsatzes von chlorsubstituierten Edukten müssen zusätzlich 10 mol% Kaliumjodid zugefügt werden.) Die Reaktionsmischung wird 5h am Rückfluß gekocht. Nach Abkühlung werden 0,5l Wasser hinzugefügt und dreimal mit 200ml Ether extrahiert. Die vereinigten Etherphasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet, der Ether am Rotationsverdampfer abgezogen und der Rückstand im Vakuum destilliert.

i) Auf diese Art wird beispielsweise aus  $\alpha,\alpha$ -Dibrommethylbenzol-1,4 und 3-Ethyl-3-hydroxymethyloxetan die folgende Bis-oxetanverbindung hergestellt.

ii) Auf diese Art wird beispielsweise aus Benzylbromid und 3-Ethyl-3-hydroxymethyloxetan die folgende Mono-oxetanverbindung hergestellt.

iii) Auf diese Art wird beispielsweise aus Pentaerytrit und
 3-Ethyl-3-chlormethyloxetan die folgende Tetra-oxetan-verbindung hergestellt, die nur im Vakuum bei Drücken unter
 10<sup>-5</sup> mb destillierbar ist.

25 q) Allgemeine Vorschrift zur Synthese der oxetan-funktionalisierten CTM

Beispiel 27

30 mmol einer ungeschützten chromophoren Verbindung II, IIa, IV, VII, IX, X, XI oder XII, nach Beispiel 22, werden unter Rühren, Feuchtigkeitsausschluß und Inertgasspülung mit 30mmol kupplungsfähiger Oxetanverbindung, nach Beispiel 25 bzw. 23, und 60 mmol) Triphenylphosphin in 250ml trockenem THF (trockenem NMP (N-Methyl-pyrolidon) bei polymeren Chromophoren) gelöst. Danach werden 60 mmol Azodicarbonsäurediethylester, gelöst in 50ml THF, langsam bei Raumtemperatur zugetropft. Zur Vervollständigung des Umsatzes wird weitere 8h bei 30°C gerührt. Schließlich werden die oxetanfunktionalisierten CTM 10 durch Eintropfen in rührendes Methanol gefällt (eventuell Zugabe von etwas Wasser), abgesaugt und getrocknet. Das dabei erhaltene polymere Rohprodukt wird durch Zusatz von THF vollständig gelöst und wiederholt zur Reinigung in Methanol umgefällt. Die Rohprodukte der nichtpolymeren oxetanfunktionali-15 sierten CTM werden säulenchromatographisch auf Kieselgel gereinigt.

## r) Fertigung einer OLED durch vernetzte Schichten

20 Beispiel 28

WO 02/21611

- Substratvorbereitung (Reinigung und ITO-Strukturierung [ITO = Indium-Zinn-Oxid])
- Herstellen eines Lackes aus einem vernetzbaren Lösungsmittel, nach Beispiel 26, einem oxetanfunktionalisierten
  Lochtransportmaterial mit Het = II oder IIa, nach Beispiel
  27, und 1 Ma% Photoinitiator (bezogen auf die Masse oxetanfunktionalisierter Verbindungen) z.B. 4-(Thiophenoxyphenyl)-diphenylsulfoniumhexafluoroantimonat, (eventuell
  auch Zusätze anderer Lösungsmittel um Druck-, Rakel- bzw.
  Spincoating-parameter einzustellen)
  - Aufbringen einer oxetanfunktionalisierten Lochtransportschicht auf das Substrat
  - Entfernen des Lösungsmittels im Vakuum
- 35 Auflegen einer Belichtungsmaske

5

- Belichten mit UV-licht 300 nm (Belichtungszeit optimieren, abhängig von Abstand und Leistung), bei der Beschichtung der Substrate muß die Schichtdicke so optimiert werden, dass sie nach der Vernetzung die gewünschte Höhe (zwischen 50nm und 100nm) hat.
- Mit einem geeigneten Lösungsmittel (Aceton, Chloroform, THF) die von der Maske abgedeckten Bereiche des Substrates auf einem Spincoater wegspülen.
- kurzes Trocknen im Vakuum
- herstellen eines Lackes aus einem vernetzbaren Lösungsmittel, nach Beispiel 26, einem oxetanfunktionalisierten E-lektronentransportmaterial welches gleichzeitig Emittereigenschaften besitzt mit Het = IV, VII, IX, X, XI oder XII, nach Beispiel 27, und 1 Ma% Photoinitiator (bezogen auf
- die Masse oxetanfunktionalisierter Verbindungen) z.B. 4(Thiophenoxy-phenyl)-diphenylsulfoniumhexafluoroantimonat, (eventuell auch Zusätze anderer Lösungsmittel
  um Druck-, Rakel- bzw. Spincoating-parameter einzustellen), zusätzlich können dem Lack auch andere nicht ver-
- netzbare und /oder vernetzbare Emittermaterialien ebenso wie andere nicht vernetzbare und/oder vernetzbare Elektronentransportmaterialien beigemischt werden, um gewünschte Emissionseigenschaften und Elektronentransportegenschaften zu erzeugen.
- 25 Aufbringen einer oxetanfunktionalisierten Elektronentransportschicht auf das Substrat, welche gleichzeitig Emittereigenschaften besitzt.
  - Entfernen des Lösungsmittels im Vakuum
  - Auflegen einer Belichtungsmaske
- Belichten mit UV-licht 300 nm (Belichtungszeit optimieren, abhängig von Abstand und Leistung), bei der Mehrfachbeschichtung der Substrate muß die Schichtdicke so optimiert werden, dass sie nach der Vernetzung die gewünschte Gesamthöhe (bestehende Schichtdicke + 50nm bis 100nm) hat.
- 35 Mit einem geeigneten Lösungsmittel (Aceton, Chloroform, THF) die von der Maske abgedeckten Bereiche des Substrates auf einem Spincoater wegspülen.

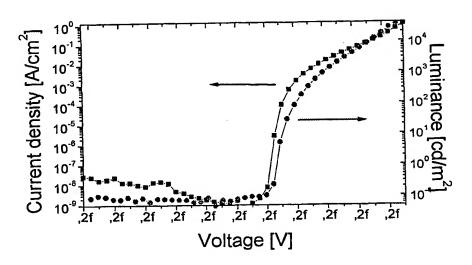
WO 02/21611 PCT/DE01/03346

35

- Der Beschichtungsvorgang wird nun sooft wiederholt, bis die gesamte OLED-Fläche mit Elektronentransport- und/oder Emittermaterialien abgedeckt ist.
- Aufdampfen einer 40 nm dicken Ca-Kathode im Vakuum
- 5 Hermetische Verkapselung der elektrooptischen Anordnung mit herausgeführten Elektrodenanschlüssen.
  - Spannung anlegen Lumineszenz

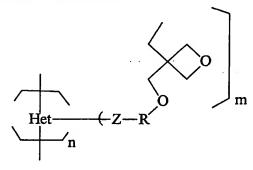
Stromdichte und Leuchtdichte für eine OLED mit folgender 10 Schichtanordnung:

- ITO-Glassubstrat
- 60 nm Lochtransportschicht II nach Beispiel 4
- 60nm Chromophorschicht IX nach Beispiel 17
- 40nm Ca



### Patentansprüche

- 1. Oxetan-funktionalisierte niedermolekulare, oligomere oder (pre)polymere Verbindung, die halbleitende und/oder lumineszierende Eigenschaften hat und durch thermische Behandlung und/oder durch Bestrahlung vernetzbar ist.
- 2. Oxetan-funktionalisierte Verbindung nach Anspruch 1 der folgenden allgemeinen Struktur:



CTM

10

25

5

für das folgendes gilt:

15 Het sind die heterocyclischen Grundkörper der ladungstransportierenden Verbindungen,

Z sind die Substituenten R³ und/oder R⁴ der heterocyclischen Grundkörper, die unabhängig voneinander oder beide eine Funktion tragen, die zur Anknüpfung an den Spacer R geeignet ist,

die Gruppe der einsetzbaren Spacer R umfasst verzweigte oder unverzweigte, unsubstituierte Alkylenketten, vorzugsweise  $C_1$  bis  $C_8$ -Ketten, und/oder etherhaltige Alkylenketten und/oder aromatenhaltige Alkylenketten.

Die Zahl der Repititionseinheiten n umfaßt die Werte 1 bis 100.

Die Anzahl der vernetzbaren Gruppierungen m pro Repititionseinheit umfaßt die Werte 1 und 2. WO 02/21611 PCT/DE01/03346

3. Oxetan-funktionalisierte Verbindung nach Anspruch 2, wobei die Gruppe Z-Het ausgewählt ist aus der Gruppe, die folgende Verbindungen umfasst:

37

2-Aminothiophenderivate II und IIa

10

25

30

5 5-akzeptor-funktionalisierte 2-N, N-Diarylamino-thiophene IV 2, 3-Bishtienylchinoxaline VII

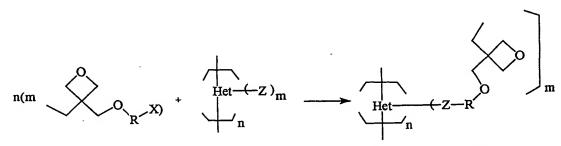
1,4-Bis-1,1'-dithienyl-2,2'-diaryl-bzw.-2,2,2',2'-tetraaryl-styrylbenzene IX

1,1-Dithienyl-2,2-diakzeptor-funktionalisierte Ethylene X 1-Thienyl-1-methyl-2,2-diakzeptor-funktionalisierte Ethylene

4,6-bisthienyl-funktionalisierte 1,3,2-Dioxaborine XII.

4. Oxetan-funktionalisierte Verbindung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Spacer R, über den die OxetanFunktion durch eine Ethergruppierung kovalent gebunden ist,
mit dem Oxetan-Ring vorzugsweise über eine Ether- oder Amingruppierung mit einem Arylrest R3 und/oder R4 der ladungstransportierenden Verbindung verknüpft ist, wobei sich folgende Möglichkeiten der Anbindung bieten: Phenolether, Benzylether, Phenolthioether, und/oder tertiäres Amin.

5. Verfahren zur Herstellung einer oxetan-funktionalisierten Verbindung durch Kondensation und/oder HX-Eliminierung nach folgendem allgemeinen Reaktionsschema:



wobei R, Z, Het n und m die in Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen haben und

 ${\bf X}$  ein Halogen oder OH, je nach dem angewandten Reaktionstyp zur Verknüpfung von  ${\bf Z}$  mit  ${\bf R}$ , ist.

6. Verfahren zur Herstellung zumindest einer halbleitenden und/oder lumineszierenden Schicht durch Vernetzung einer oxetan-funktionalisierten Verbindung.

5

- 7. Verfahren nach Anspruch 6, folgende Verfahrensschritte umfassend:
- Beschichtung eines Substrates durch ein Verfahren aus Lösung und/oder aus Substanz mit der oxetan-funktionalisierten Verbindung, die in Lösung oder in Substanz vorliegen
  kann,
  - Vernetzung des entstandenen Films.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, bei dem der Film vor der Vernetzung noch getrocknet wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, bei dem die oxetan-funktionalisierte Verbindung in Lösung aufgebracht
   wird und die Lösung weitere Komponenten wie Bindemittel, Reaktivverdünner, Vernetzer, thermischen Initiator und/oder Photoinitiator enthält.
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, bei dem die Vernetzung durch thermisch latente Lewis-Säuren, durch Photosäuren, Photoinitiatoren und/oder durch Bestrahlung mit elektromagnetischer und/oder aktinischer Strahlung initiiert wird.
- 30 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, bei dem eine Strahlung der Wellenlänge zwischen 200nm und 600 nm eingesetzt wird.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11, durch das eine halbleitende Schicht mit einer Schichtdicke im Bereich von einigen Nanometern bis hin zu Millimetern hergestellt wird.

WO 02/21611 PCT/DE01/03346

39

- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 12, durch das eine Schicht im Bereich von 25 bis 250 nm hergestellt wird.
- 5 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 13, bei dem die halbleitende Schicht strukturiert wird.
- 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 14, bei dem die halbleitende und/oder lumineszierende Schicht durch bildgemä10 ßes Belichten strukturiert wird.
  - 16. Verfahren zur Herstellung einer halbleitenden und/oder lumineszierenden Schicht und/oder Synthese der Materialien zur Herstellung dieser Schicht über metallkatalysefreie Verfahrensschritte.
- 17. Organische Licht emittierende Diode (OLED), zumindest ein Substrat, eine Anodenschicht, eine Lochtransportschicht, eine Emitterschicht, die gleichzeitig auch eine Elektronentrans20 portschicht sein kann, eine Kathode und eine Verkapselung umfassend, wobei die Lochtransportschicht und/oder die Elektronentransportschicht/Emitterschicht ein Material nach den Ansprüchen 1 bis 4 umfasst.

15

Interna ...ation No PCT/DE 01/03346

Relevant to claim No.

1,2,5

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L51/20 H01L51/30 C07D305/06 C07D409/14 C07D409/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### **B. FIELDS SEARCHED**

Category °

X

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 HO1L CO7D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages

DE 38 27 221 A (BAYER AG)

the whole document

15 February 1990 (1990-02-15)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

X	EP 0 848 294 A (JAPAN SYNTHET LTD ;JAPAN FINE COATINGS CO L 17 June 1998 (1998-06-17) the whole document		1,2,5
X	EP 0 728 790 A (HERAEUS KULZE 28 August 1996 (1996-08-28) the whole document	R GMBH)	1,2,5
X	FR 1 501 297 A (CIBA GEIGY) 10 November 1967 (1967-11-10) page X		1,2,5
		-/	
		•	•
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.
"A" docum consid "E" earlier filling o "L" docume which citatio "O" docume other "P" docume later to	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"T" later document published after the Inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th invention  "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or ments, such combination being obvio in the art.  "&" document member of the same patent	the application but early underlying the selaimed invention to considered to cument is taken alone slaimed invention ventive step when the one other such docu- us to a person skilled family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
3	1 January 2002	25/02/2002	
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Francois, J	

Inte ation No
PCT/DE 01/03346

C (Cartie	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PC1/DE 01/03346
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
————	Oldfort of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Nelevant to claim No.
X	DE 199 13 543 A (KANAGAWA UNIVERSITY YOKOHAMA) 30 September 1999 (1999-09-30) the whole document	1,2,5
X	GB 2 305 919 A (KANSAI PAINT CO LTD) 23 April 1997 (1997-04-23) the whole document	1,2,5
X .	US 5 463 084 A (J.V.CRIVELLO,H.SASAKI) 31 October 1995 (1995-10-31) claims; figures 2-4,14-16; table 1	1,2,5,6, 10,11
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 69, 30 July 1999 (1999-07-30) & JP 11 106380 A (UBE), 20 April 1999 (1999-04-20) abstract	1,2,5
<b>X</b>	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 130, no. 14, 1999 Columbus, Ohio, US; abstract no. 183514r, page 753; column 2; XP002188882 abstract & JP 01 117074 A (JSR CO.) 22 January 1999 (1999-01-22)	1,2,5,6, 14-17
Α	US 5 518 824 A (D.FUNHOFF ET AL.) 21 May 1996 (1996-05-21) cited in the application the whole document	1,2,6-17
Ρ,Χ	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 135, no. 5, 2001 Columbus, Ohio, US; abstract no. 68558z, page 1402; column 2; XP002188883 abstract & JP 2001 174986 A (HITACHI CHEMICAL) 29 June 2001 (2001-06-29)	1,2,6, 14-17
P,X	WO 01 12745 A (MITSUI CHEMICALS) 22 February 2001 (2001-02-22) the whole document & EP 1 138 739 A (MITSUI CHEM.) 4 October 2001 (2001-10-04)	1,2,5-17

Interm Ition No
PCT/DE 01/03346

		PCT/DE 0	1/03346			
	(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	<del></del> _	Relevant to claim No.			
Х	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 135, no. 24, 2001 Columbus, Ohio, US; abstract no. 345501s, page 831; XP002188884 abstract		1,2,6-17			
E	& JP 2001 303014 A (HITACHI CHEM.) 31 October 2001 (2001-10-31)		1,2,6-17			
	·					
!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			8			
	*	· .				
•						

International application No.

PCT/DE01/03346

FURTHER INFORMATION

PCT/ISA/210

Continuation of box 1.2

Claims Nos. 1, 2 (all partially)

The search yielded already in the initial phase a very large number of novelty-destroying documents. These documents are so numerous that it is impossible to establish for what subject matter protection could be justifiably sought for the totality of the claims. (Art. 6 PCT). For this reason a meaningful search covering the entire scope of protection sought is impossible. The search was therefore restricted to: compounds comprising Het (according to claims 1 and 2) = a saturated heterocycle, and having semiconductor properties.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of an international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). EPO policy, when acting as an International Preliminary Examining Authority, is normally not to carry out a preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case, irrespective of whether or not the claims are amended following receipt of the search report (Article 19 PCT) or during any Chapter II procedure whereby the applicant provides new claims.

Intern :ation No
PCT/DE 01/03346

	document earch report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 38	27221	A	15-02-1990	DE EP JP	3827221 0363585 2101066	A1	15-02-1990 18-04-1990 12-04-1990
EP 08	48294	A	17-06-1998	JP US DE EP	10168165 5981616 69706816 0848294	A D1	23-06-1998 09-11-1999 25-10-2001 17-06-1998
EP 07	28790	Α	28-08-1996	DE DE EP JP JP US	19506222 59605086 0728790 2880446 8245783 5750590	D1 A1 B2 A	29-08-1996 08-06-2000 28-08-1996 12-04-1999 24-09-1996 12-05-1998
FR 15	01297	A	10-11-1967	GB US	1129028 3449340		02-10-1968 10-06-1969
DE 19	913543	A	30-09-1999	JP DE US	11279277 19913543 6124402	A1	12-10-1999 30-09-1999 26-09-2000
GB 23	05919	A	23-04-1997	JP JP US	3162634 9309950 5721020	Α .	08-05-2001 02-12-1997 24-02-1998
US 540	53084	· A	31-10-1995	JP JP JP JP	3074086 6016804 11322735 2000001482	A A	07-08-2000 25-01-1994 24-11-1999 07-01-2000
JP 11:	106380	A	20-04-1999	NONE			
JP 11:	17074	Α	09-05-1989	NONE			
US 55	18824	А	21-05-1996	DE CN DE EP ES JP	4325885 1103230 59407212 0637899 2122108 7114987	A D1 A1 T3	09-02-1995 31-05-1995 10-12-1998 08-02-1995 16-12-1998 02-05-1995
JP 200	01174986	Α	29-06-2001	NONE			
WO 01:	12745	A	22-02-2001	CN EP WO JP	1320146 1138739 0112745 2001139933	A1 .	31-10-2001 04-10-2001 22-02-2001 22-05-2001

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int--tenzeichen PCT/DE 01/03346

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L51/20 H01L51/30 C07D305/06 CO7D409/14 CO7D409/12

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 7 H01L C07D

Recherchierl	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowe	eit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während der	rinternationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nar	ne der Datenbank und evil. verwendete	Suchbegriffe)
	cernal, WPI Data, PAJ		
	INTERNATIONALER REC	HERCHENBERICHT	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	J. Tana	Date Appendigh Nr
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	DE 38 27 221 A (BAYER AG) 15. Februar 1990 (1990-02-15) das ganze Dokument		1,2,5
X	EP 0 848 294 A (JAPAN SYNTHETIC RULTD ;JAPAN FINE COATINGS CO LTD (C 17. Juni 1998 (1998-06-17) das ganze Dokument	1,2,5	
X	EP 0 728 790 A (HERAEUS KULZER GME 28. August 1996 (1996-08-28) das ganze Dokument	1,2,5	
X	FR 1 501 297 A (CIBA GEIGY) 10. November 1967 (1967-11-10) Seite X		1,2,5
		/	
X Wei	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu iehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besonder  'A' Veröffe aber I  'E' älleres Anme  'L' Veröffe scheit ander soll o ausge 'O' Veröffe eine I  'P' Veröffe	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :  Intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist  Intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- enen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie sichnt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausselfung oder andere Maßnahmen bezieht partichung, die vor dem internationalen Ammeldedatum, aber nach	T' Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlic Anmeldung nicht kollidiert, sondem r Erfindung zugrundeliegenden Prinzig Theorie angegeben ist X' Veröffentlichung von besonderer Bed kann allein aufgrund dieser Veröffent erfinderischer Tätigkeit beruhend bei Y' Veröffentlichung von besonderer Bed kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung in Veröffentlichung nieser Kategorie diese Verbindung für einen Fachmar & Veröffentlichung, die Mitglied derselb	ur zum Verstahtnis des der is oder der ihr zugrundeliegenden eutung; die beanspruchte Erfindung lichung nicht als neu oder auf rachtet werden eutung; die beanspruchte Erfindung gkeit beruhend betrachtet ilt einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und n nahellegend ist
	heanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen f	
	31. Januar 2002	25/02/2002	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Francois, J	

## . INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern 1zelchen
PCT/UL U1/U3346

	rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		·
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	nden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 199 13 543 A (KANAGAWA UNIVERSITY YOKOHAMA) 30. September 1999 (1999-09-30) das ganze Dokument		1,2,5
X	GB 2 305 919 A (KANSAI PAINT CO LTD) 23. April 1997 (1997-04-23) das ganze Dokument		1,2,5
X	US 5 463 084 A (J.V.CRIVELLO,H.SASAKI) 31. Oktober 1995 (1995-10-31) Ansprüche; Abbildungen 2-4,14-16; Tabelle 1	·	1,2,5,6, 10,11
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 69, 30. Juli 1999 (1999-07-30) & JP 11 106380 A (UBE), 20. April 1999 (1999-04-20) Zusammenfassung		1,2,5
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 130, no. 14, 1999 Columbus, Ohio, US; abstract no. 183514r, Seite 753; Spalte 2; XP002188882 Zusammenfassung & JP 01 117074 A (JSR CO.) 22. Januar 1999 (1999-01-22)		1,2,5,6, 14-17
<b>A</b>	US 5 518 824 A (D.FUNHOFF ET AL.) 21. Mai 1996 (1996-05-21) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument		1,2,6-17
Ρ,Χ	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 135, no. 5, 2001 Columbus, Ohio, US; abstract no. 68558z, Seite 1402; Spalte 2; XP002188883 Zusammenfassung & JP 2001 174986 A (HITACHI CHEMICAL) 29. Juni 2001 (2001-06-29)		1,2,6, 14-17
P,X	WO 01 12745 A (MITSUI CHEMICALS) 22. Februar 2001 (2001-02-22) das ganze Dokument & EP 1 138 739 A (MITSUI CHEM.) 4. Oktober 2001 (2001-10-04)	•	1,2,5-17

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interi enzeichen
PCT/DE 01/03346

ategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 135, no. 24, 2001 Columbus, Ohio, US; abstract no. 345501s, Seite 831; XP002188884 Zusammenfassung & JP 2001 303014 A (HITACHI CHEM.)	1,2,6-17	
	31. Oktober 2001 (2001–10–31)		

## **WEITERE ANGABEN**

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld I.2

Ansprüche Nr.: 1,2(alle teilweise)

Die Recherche ergab in ihrer Anfangsphase eine sehr große Zahl neuheitsschädlicher Dokumente. Diese Zahl ist so groß, daß sich unmöglich feststellen lässt, für was in der Gesamtheit der Patentansprüche eventuell nach zu Recht Schutz begehrt werden könnte (Art. 6 PCT). Aus diesen Gründen erscheint eine sinnvolle Recherche über den gesamten Bereich der Patentansprüche unmöglich. Die Recherche wurde daher beschränkt auf: Verbindungen mit Het (nach Ansprüche 1 und 2)= gesättigt Heterozyclus und mit halbleiterEigenschaften.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Patentansprüche, oder Teile von Patentansprüchen, auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, daß die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, daß der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäß Kapitel II PCT neue Patentansprüche vorlegt.

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internati izelchen
PCT/DE 01/03346

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	١	Mitglied(er) der Patentfamille	Datum der Veröffentlichung
DE 3827221	A	15-02-1990	DE EP JP	3827221 A1 0363585 A1 2101066 A	15-02-1990 18-04-1990 12-04-1990
EP 0848294		17-06-1998	JP US DE EP	10168165 A 5981616 A 69706816 D1 0848294 A1	23-06-1998 09-11-1999 25-10-2001 17-06-1998
EP 0728790	A	28-08-1996	DE DE EP JP JP US	19506222 A1 59605086 D1 0728790 A1 2880446 B2 8245783 A 5750590 A	29-08-1996 08-06-2000 28-08-1996 12-04-1999 24-09-1996 12-05-1998
FR 1501297	Α	10-11-1967	GB US	1129028 A 3449340 A	02-10-1968 10-06-1969
DE 19913543	Α	30-09-1999	JP DE US	11279277 A 19913543 A1 6124402 A	12-10-1999 30-09-1999 26-09-2000
GB 2305919	Α	23-04-1997	JP JP US	3162634 B2 9309950 A 5721020 A	08-05-2001 02-12-1997 24-02-1998
US 5463084	Α	31-10-1995	JP JP JP JP	3074086 B2 6016804 A 11322735 A 2000001482 A	07-08-2000 25-01-1994 24-11-1999 07-01-2000
JP 11106380	Α	20-04-1999	KEIN	E	
JP 1117074	Α	09-05-1989	KEIN	IE 	
US 5518824	A	21-05-1996	DE CN DE EP ES JP	4325885 A1 1103230 A 59407212 D1 0637899 A1 2122108 T3 7114987 A	09-02-1995 31-05-1995 10-12-1998 08-02-1995 16-12-1998 02-05-1995
JP 2001174986	5 A	29-06-2001	L KEI	NE	ے کہ سانی ساند کی در ساند میں اس کا در اسان میں اس کے ک
WO 0112745	A	22-02-200	I CN EP WO JP	1320146 T 1138739 A1 0112745 A1 2001139933 A	31-10-2001 04-10-2001 22-02-2001 22-05-2001
JP 200130301	 4 <i>P</i>	31-10-200	1 KEI	NE	